

(11) Publication number:

11346141 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 10150374

(51) Intl. Cl.: H03H 9/25

(22) Application date: 29.05.98

(30) Priority:

(43) Date of application

14.12.99

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: KYOCERA CORP

(72) Inventor: ITO MIKI

OTSUKA KAZUHIRO

(74) Representative:

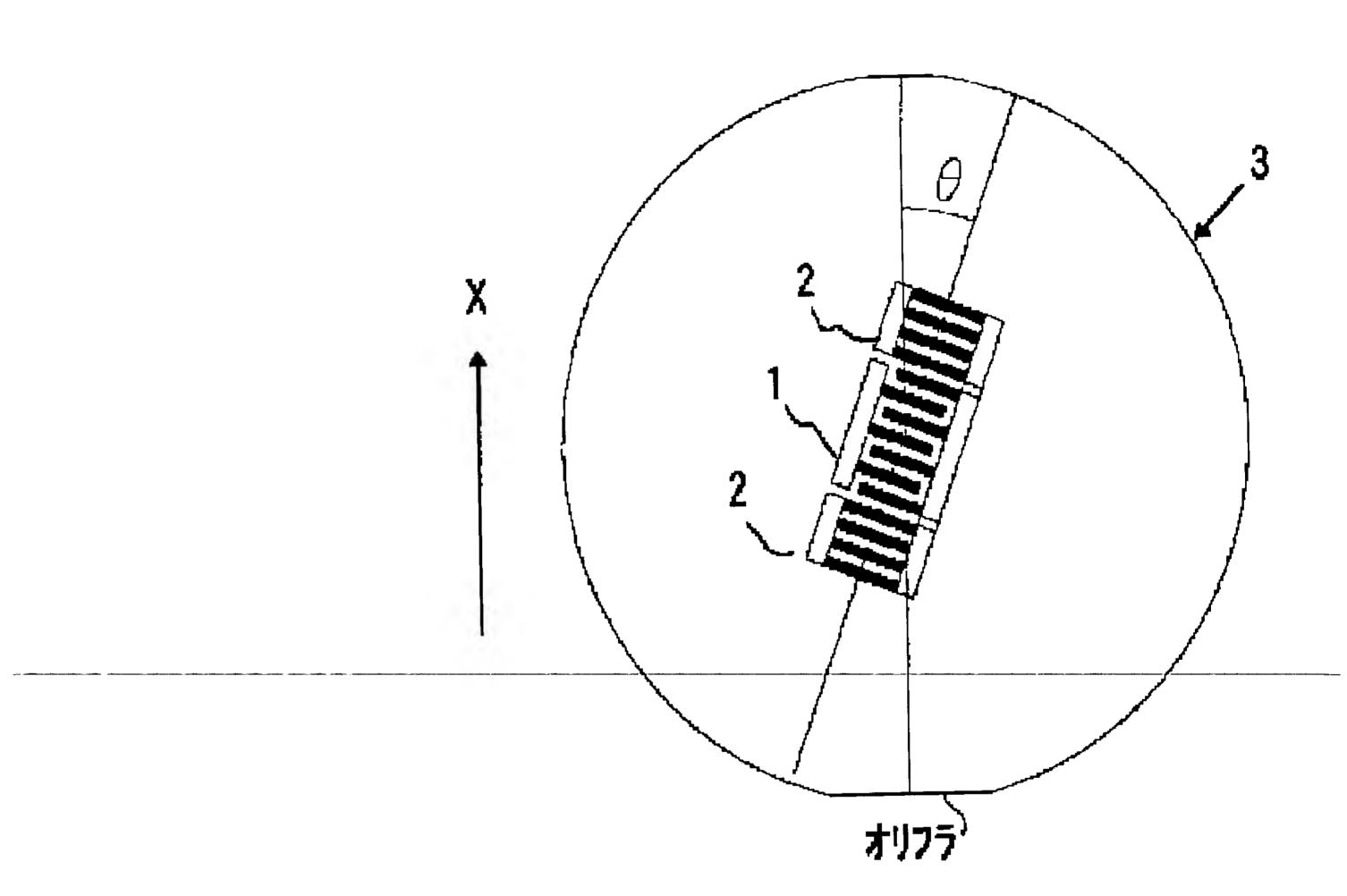
(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface acoustic wave filter which sets the cut angle of a piezoelectric substrate and the carrier direction of an SAW to an optimal direction, enables formation of a SAW resonator having characteristics in which Δf is increased and has wideband filter characteristics.

solution: This device is a surface acoustic wave device S, which is composed by disposing a combshaped excitation electrode 1 on at least one of main surfaces of a piezoelectric substrate. The piezoelectric substrate is composed of a niobic acid lithium single-crystal of 61° to 67°Y cut and an angle made by the carrier direction of the surface acoustic wave generated by the excitation electrode 1 and an X-axis of the single crystal is set in the range between 2° and 7°.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-346141

(43)公開日 平成11年(1999)12月14日

(51) Int.Cl.⁶

HO3H 9/25

識別記号

FΙ

H 0 3 H 9/25

C

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平10-150374

(22)出願日

平成10年(1998) 5月29日

(71) 出題人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(72)発明者 伊藤 幹

京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京

セラ株式会社中央研究所内

(72)発明者 大塚 一弘

京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京

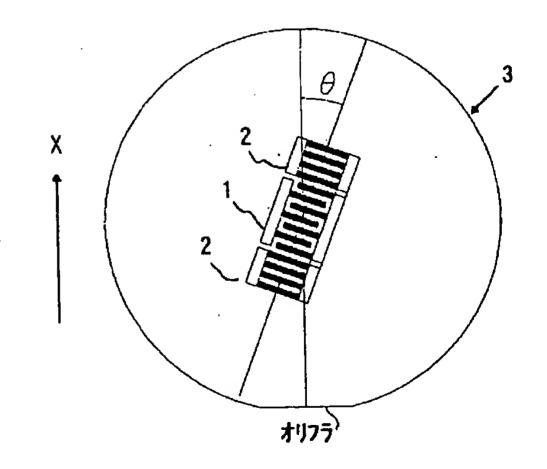
セラ株式会社中央研究所内

(54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

(57) 【要約】

【課題】 圧電基板のカット角やSAW の伝搬方向が最適な方向に設定し、△f が増加した特性を持つSAW 共振子を 形成可能とし、広帯域なフィルタ特性を持つ弾性表面波フィルタを提供すること。

【解決手段】 圧電基板の少なくとも一主面上に、櫛歯状の励振電極1を配設して成る弾性表面波装置Sであって、前記圧電基板が61°~67° Yカットのニオブ酸リチウム単結晶から成るとともに、励振電極1により発生した弾性表面波の伝搬方向と単結晶のX軸のなす角度が2°~7°であるものとする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板の少なくとも一主面上に、櫛歯状の励振電極を配設して成る弾性表面波装置であって、前記圧電基板が61°~67° Yカットのニオブ酸リチウム単結晶から成るとともに、前記励振電極により発生した弾性表面波の伝搬方向と前記単結晶のX軸のなす角度が2°~7°であることを特徴とする弾性表面波装置。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば自動車電話 および携帯電話等の移動体無線機器等に内蔵される周波 数帯域フィルタやデュプレクサ等に好適な弾性表面波装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、移動体通信用の周波数帯域フィルタは広帯域化が要求されるようになってきており、中心周波数に対する通過帯域幅の比率は、例えば中心周波数942MHzに対して、35MHz(約3.7%)に増加している。また、温度によるフィルタ特性のシフト分と、製造時の特性ばらつき分とを考慮し、通常は通過帯域幅は上記要求より大きめ(例えば約50MHz、約5.3%)に設定する必要がある。

【0003】従来の単純化した弾性表面波(Surface Acoustic Wave、以下、SAW ともいう)フィルタの例を図2に示す。同図は移動体通信用のラダー型(梯子型)のSAWフィルタであって、2.5段π型と称されるSAWフィルーターSの回路図を模式的に示したものである。

【0004】図2において、11、12は直列SAW 共振子、 13~15は並列SAW 共振子、1 は所定数の電極指から成る 1 対の櫛歯状の励振電極であるIDT(Inter Digital Tran sducer) 電極、2 はIDT 電極1 のSAW 伝搬路の両端に設 けられ、SAW を効率良く励振させるための梯子型の反射 器である。そして、直列SAW 共振子11、12と並列SAW共 振子13~15を並列、直列交互に多段接続してSAW フィル タSを構成している。また、図3は上記SAW 共振子の基 本構成を示す平面図である。このようなSAW フィルタ は、例えばLiTaO3(タンタル酸リチウム)単結晶やLiNb 03 (ニオブ酸リチウム) 単結晶等の圧電基板の主面上 に、アルミニウム等から成る励振電極が配設されてい る。なお、図3について電極指の数等は、簡単のため単 純化しており、正確に表現したものではなく、以下に説 明する各図においても、一般に電極指の本数は数10~数 100 本に及ぶため図示を簡略化している。

【0005】図5は図3に示すようなSAW 共振子Aをインピーダンスアナライザ等に接続し入力インピーダンス (Zin) の周波数特性図である。同図において、横軸は周波数、縦軸はZin の絶対値 | Zin | である。またf1は | Zin | が最小となる周波数 (共振点) であり、f2は | Zin | が最大となる周波数 (反共振点) である。

【0006】共振点f1と反共振点f2はSAW フィルタを構成する上で重要であり、共振点f1と反共振点f2との周波数幅分fが、SAW フィルタの通過帯域幅を決定する大きな要因となっている。また、この分f を増加させることが、通過帯域幅の増加につながるため、分f を増加させる手法が種々検討されており、特に電極形状を工夫して公f を増加させる方法が検討されている。

【0007】例えば、図4 に示すように△f を増加させるSAW 共振子Bが提案されている。このSAW 共振子BはIDT 電極1 の電極指と電極指との間隔d を順次増加(減少) させた構造、いわゆるチャープ型電極となっている(例えば、特開平9-130201号公報等を参照)。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようにチャープ型電極の設計に従ってSAW 共振子を作製しても、共振点f1に好ましくないスプリアス共振が発生することがあり、これによりSAW 共振子を直並列に接続した弾性表面波フィルタにおいて、良好なフィルタ特性が得られないという問題が生じる。このようなスプリアス共振の一例を入力インピーダンス(Zin)の周波数特性図である図6に示す。

【0009】上記のように電極構造を工夫して△f を増加させる方法が好ましい結果にならない原因の一つとして、圧電基板のカット角やSAW の伝搬方向が最適な方向になされていないことが挙げられる。

【0010】例えば、LiNbO3単結晶の場合、64°Yカット角で弾性表面波の伝搬方向とX 軸が一致するものが一般的であり、 △f を共振点の周波数f1で規格化した値△f/f1は約5%程度である。すなわち、 △f は圧電基板のカット角やSAW の伝搬方向で決定される材料特性で、概ね増加することができる範囲が決まっている。

【0011】本発明は上記事情に鑑みて完成されたものであり、その目的は従来と同様のチャープ型でない電極構造でありながら、△fが増加した特性を持つSAW共振子を形成可能とし、広帯域なフィルタ特性を持つ弾性表面波フィルタを提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の弾性表面波装置は、圧電基板の少なくとも一主面上に、櫛歯状の励振電極を配設して成る弾性表面波装置であって、前記圧電基板が61°~67° Yカットのニオブ酸リチウム単結晶から成るとともに、前記励振電極により発生した弾性表面波の伝搬方向と前記単結晶のX軸のなす角度が2°~7°であることを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明に係るSAW 装置の実施形態について図面に基づき詳細に説明する。

【0014】図1はLiNbO3単結晶とSAW 共振子のSAW 伝 搬方向との関係を示す平面図である。図1において、150 は互いに噛み合うように形成された櫛歯状の励振電極で

-2-

あるIDT 電極、 2はIDT 電極の両端のSAW 伝搬路上に設けられた梯子型の反射器、 3は61° \sim 67° YカットのLiNbO3単結晶(圧電基板を切り出すためのウエハ)の上面図である。なお、SAW 伝搬方向はIDT 電極および反射器の電極指に対して垂直であり、LiNbO3単結晶のX 軸方向とSAW 伝搬方向のなす角度を θ としている。

【0015】圧電基板のカット角を変更することは、単結晶の作製工程の条件変更等を伴い、コストが高くなる等の不具合があるため、比較的容易に変更できるSAW 伝搬方向のなす角度 θ を変化させてSAW 共振子を形成した。

【0016】 θ を変化させてSAW 共振子を形成し、インピーダンスアナライザ等に接続し入力インピーダンス(Zin) の周波数特性を測定した一例を図7に示す。同図において、横軸は周波数、縦軸はZin の絶対値 | Zin | である。破線は従来の $\theta=0$ ° で形成したSAW 共振子の周波数特性、実線は $\theta=5$ ° で形成したSAW 共振子の周波数特性である。周波数特性を比較すると、 $\theta=5$ ° の周波数特性の方が $\theta=0$ ° の周波数特性に比較して Δf が増加していることが分かった。

【0017】上記のように θ を変化させることにより、 $\triangle f$ が変化することを発見したため、更に θ の好適な範囲を求めるため、SAW 共振子の周波数特性の θ 依存性を調査した。

【0018】図8は、LiNb03単結晶のX軸方向とSAW 伝搬方向のなす角度 θ と、 Δf を共振点の周波数f1で規格化した値 Δf /f1の関係を示すグラフである。同図において、横軸は θ 、縦軸は Δf /f1である。このグラフから分かるように、 θ の増加とともに Δf /f1も増加し、 θ =約6°でほぼ一定の値を示す傾向にあることが分かった。以上の結果から、 Δf を増加させるためには、 θ >0°であれば良く、より好適はフィルタ特性の通過帯域幅BWを中心周波数 f0 で規格化したBW/f0 は約5.3%必要され、また、共振周波数 f1 と反共振周波数 f2 の差 Δf を共振周波数 f1 で規格化した Δf /f1 Δf の値がBW/f0 とほぼ等しいため、 Δf /f1 Δf 5.3%となるところがより望ましいことになる。すなわち、図8から明らかなように、 Δf 0 Δf 0 であることが判明した。

【0019】また、図9はLiNbO3単結晶のX 軸方向とSA 40 W 伝搬方向のなす角度 θ と、図2に示すようなSAW フィルタの挿入損失との関係を示すグラフである。同図において、横軸は θ 、縦軸は最小挿入損失である。このグラフから分かるように θ の増加とともに最小挿入損失も増加する傾向にあることが分かった。最小挿入損失は約3. 5dB 以下が必要とされるため、 $\theta \leq 7.0$ 。にする必要がある。

【0020】以上の検討により、LiNb03単結晶のX 軸方向とSAW 伝搬方向のなす角度 θ を 0 ° < θ \le 7 ° の範囲、より好適には 2 \le θ \le 7 ° とすることにより、従来

のチャープ型電極で発生していたスプリアス共振が発生 することなく、△f を増加させることができるSAW 共振 子を作製できるようにした。

【0021】ここで、IDT 電極および反射器はAIまたは AI合金(AI-Cu系、AI-Ti 系等) からなり、蒸着法、スパッタリング法またはCVD 法等の薄膜形成法により形成する。そして、IDT 電極の対数は $50\sim200$ 程度、電極指の幅は $0.4\sim10\mu$ m程度、電極指の間隔は $0.4\sim10\mu$ m程度、1DT 電極の厚みは $0.2\sim0.5\mu$ m程度とする、ことがSAW 共振子あるいはSAW フィルタとしての特性を得る上で好適である。

【0022】また、IDT 電極、反射器の上に、絶縁膜または半導電性膜を形成して、IDT 電極等を確実に保護するようにしてもよい。

【0023】また、圧電基板の厚みは0.1 ~0.5 mm程度が良く、0.1 mm未満では圧電基板が脆くなり、0.5 mm超では材料コストが大きくなる。

【0024】なお、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、弾性表面波装置は各種構成のものに適用可能であり、励振電極の形状も上記の櫛歯状に限定されない。また、SAW フィルタのかわりにSAW デュプレクサ等においても本発明が適用でき、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の変更は何等差し支えない。

[0025]

【実施例】以下に、本発明に係る弾性表面波装置のより 具体的な実施例について説明する。図 3に示すSAW 共振 子を用い、図 2に示すような2.5 段 π 型のSAW フィルタ を構成した。 64° Y カットのLiNbO3単結晶からなる圧電 基板上に、単結晶のX軸との成す角度 $\theta=5^\circ$ となる弾 性表面波の伝搬方向にAIからなるSAW フィルタ用の回路 パターンを形成することにより作製した。

【0026】具体的には、紫外線(Deep-UV)を用いた密着露光機によるフォトリソグラフィー法により、前記圧電基板用のウェハ上に多数のSAW フィルタ用のレジストのネガパターンを形成した。次いで、前記ネガパターン上に電子ビーム蒸着機でAIを形成した。その後、レジスト剥離液中で不要なAIをリフトオフし、IDT 電極等の微細な回路パターンを形成した。

【0027】その後、電子ビーム蒸着機によりIDT 電極の保護用であるSi膜をウェハ全面に形成した。次に、パターニングの終了したウェハを個々のSAW フィルタ毎にダイシング法でカットし、個々のSAW フィルタのチップをSMD(Surface Mounted Device:表面実装素子) 用のパッケージ内にシリコン樹脂により接着し、載置固定した。

【0028】次に、上記パッケージ内のSAW フィルタについて、 $30\mu m\phi$ (直径 $30\mu m$) のAuワイヤーをパッケージの電極パッドとチップ上のAI電極パッドとを接続するように超音波ボンディングした後、パッケージリッドを被せ接着し、SAW フィルタのパッケージングを終了し

-3-

た。

【0029】この時、各IDT 電極の対数は、 $105\sim120$ 対、電極指の線幅は $1.1\sim1.2~\mu$ m、電極指の間隔は $1.1\sim1.2~\mu$ m、電極指の開口幅(交差幅)は $40\sim80~\mu$ m、反射器の本数は各20本、電極の膜厚を $0.4~\mu$ m、保護用膜厚を $0.03~\mu$ mとした。

【0030】そして、比較のために、従来品も同様に作製した。電極の構成は本発明品と同じで圧電基板である LiNb03単結晶は 64° Y カットで $\theta=0^\circ$ とした。

【0031】そして、このSAW フィルタをネットワークアナライザに接続し、挿入損失の周波数特性を測定した。その結果、図10に示すように、従来品に対して通過帯域幅が大きく、且つ、通過帯域内のリップルが小さく、平坦性が良好であるという優れた特性を示した。

[0032]

【発明の効果】本発明の弾性表面波装置によれば、LiNb 03単結晶のX 軸方向とSAW 伝搬方向のなす角度 θ を 2° ~ 7° の範囲にすることにより、従来のチャープ型電極で発生していたスプリアス共振が発生することなく、△ f を増加させることができる優れたSAW 共振子が作製で 20 き、これにより、不要なスプリアス共振の発生を防止し、広帯域で特性の非常に優れた弾性表面波装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る弾性表面波共振子のSAW 伝搬方向を説明する平面図である。

【図2】本発明に係る弾性表面波装置の概略回路図であ

る。

【図3】本発明に係る弾性表面波共振子の一例を説明する平面図である。

【図4】従来のチャープ型電極を説明する平面図である。

【図5】弾性表面波共振子の入力インピーダンス | Zin | の周波数特性図である。

【図6】従来の弾性表面波共振子(チャープ型電極)の 入力インピーダンス | Zin | の周波数特性図である。

【図7】本発明の弾性表面波共振子の入力インピーダンス | Zin | の周波数特性図である。

【図8】 64° Y カットLiNb03単結晶のX 軸方向とSAW 伝 搬方向のなす角度 θ と Δf を共振周波数f1で規格化した $\Delta f/f1$ の関係を示すグラフである。

【図9】 64° Y カットLiNbO3単結晶のX 軸方向とSAW 伝 搬方向のなす角度 θ と共振抵抗のの関係を示すグラフである。

【図10】本発明の弾性表面波装置の挿入損失の周波数 特性を測定したグラフである。

(符号の説明)

1 : IDT 電極 (励振電極)

2 : 反射器

3 : 64°Y カットLiNb03単結晶基板

11, 12 : 直列共振子 13, 14, 15 : 並列共振子

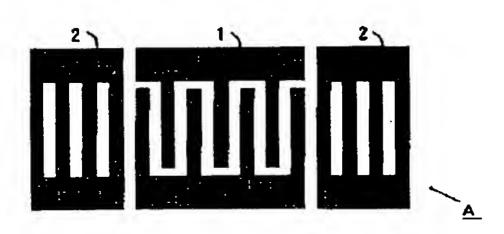
A,B: 弹性表面波共振子

S:SAW フィルタ(弾性表面波装置)

[図1]
[図2]

IN
2
IN
2
IN
157 mm

[図3]



[図4]

